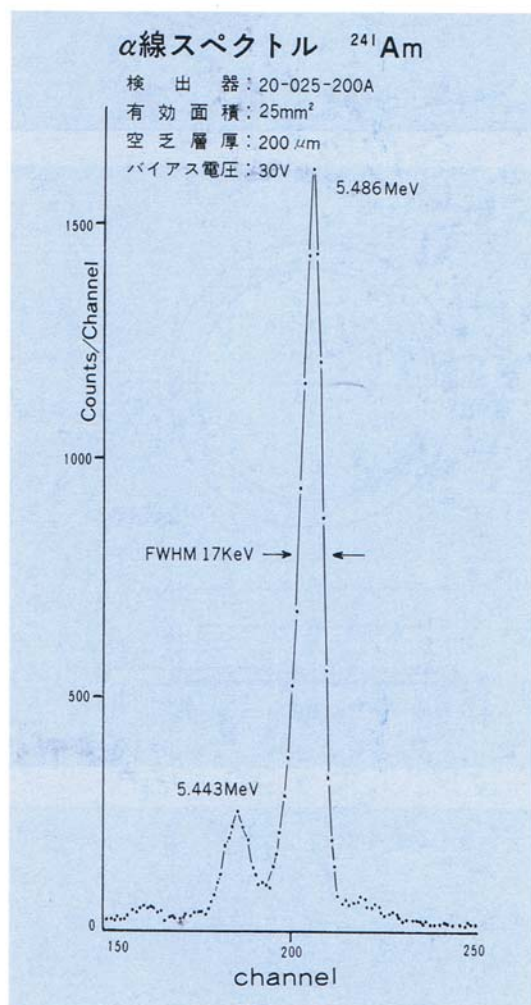
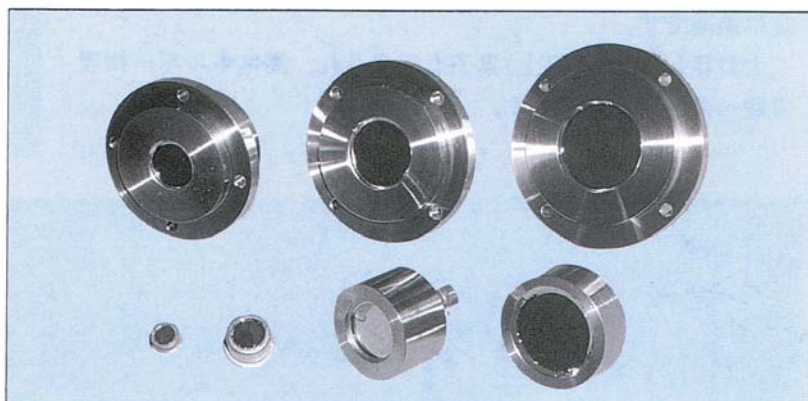


シリコンサーフェスバリア検出素子



(1) 型 式	分解能 (2) (KeV)	有効面積 (mm ²)	厚 さ (μm)	寸 法 (mm)				
				A	B	C	D	E
20-025-100 A	20		100					
20-025-200 A	20	25	200	5.7	8.2	9.2	5.7	13.5
90-025-200 A	90		200					
20-050-100 A	20		100					
20-050-200 A	20	50	200	8.0	12.2	15.2	5.7	4.5
90-050-200 A	90		200					
30-100-100 B	30		100					
30-100-200 B	30	100	200	11.5	35.0	48.0	22.0	15.0
90-100-100 B	90		100					
90-100-200 B	90		200					
30-200-100 B	30		100					
30-200-200 B	30	200	200	16.0	40.0	53.0	22.0	15.0
90-200-100 B	90		100					
90-200-200 B	90		200					
30-400-100 B	30		100					
30-400-200 B	30	400	200	22.5	46.0	59.0	22.0	15.0
90-400-100 B	90		100					
90-400-200 B	90		200					

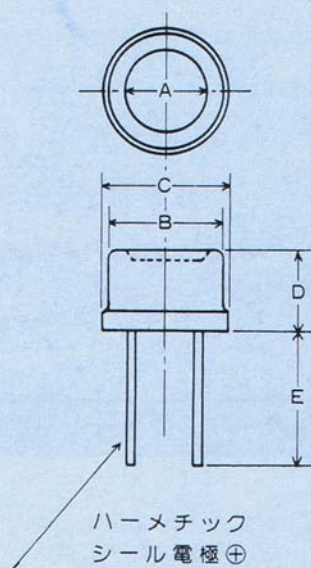
(1) 型式番号は、分解能、有効面積、最大空乏層厚さ、形状を示す。(2) ^{241}Am (5.486 MeV) α 線によるもの。



シリコンサーフェスバリア検出素子は、超高純度シリコンを用いた半導体検出器で α 線、重イオン等の測定に最適です。

本素子のエネルギー測定範囲は、 α 線で、空乏層厚さ100 μm のとき約13 MeV、200 μm のとき約20 MeVです。分解能は20 KeV以下 (^{241}Am)のものまで得られております。形状は、リードタイプとBNCタイプの2種類があり、使用目的により適したものを選ぶことができます。空乏層厚さは100 μm および200 μm 、有効面積は25～400 mm²と各種用意され、高範囲な用途に使用が可能です。

A 型 (リードタイプ)



B 型 (BNCタイプ)

